

日 本 国 特 許 庁

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年12月13日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-362200

[ST.10/C]:

[JP2002-362200]

出 願 人

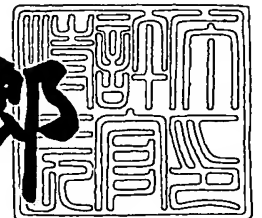
Applicant(s):

大阪大学長

2003年 4月18日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3028460

【書類名】 特許願

【整理番号】 U2002P197

【提出日】 平成14年12月13日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 G01D 15/12

【発明の名称】 磁性メモリアレイ、磁性メモリアレイの書き込み方法及び磁性メモリアレイの読み出し方法

【請求項の数】 24

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府箕面市粟生間谷西1丁目4-8-203

 【氏名】 山本 雅彦

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府豊中市春日町3-12-5-208

 【氏名】 中谷 亮一

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府豊中市西緑丘2-2-4-442

 【氏名】 遠藤 恭

【特許出願人】

 【識別番号】 391016945

 【氏名又は名称】 大阪大学長 岸本 忠三

【代理人】

 【識別番号】 100072051

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 杉村 興作

【選任した代理人】

 【識別番号】 100059258

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 杉村 暁秀

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9709713

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁性メモリアレイ、磁性メモリアレイの書き込み方法及び磁性メモリアレイの読み出し方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 外周部を円弧状に切り欠いてなる、リング形状の膜面を有する磁性層を含む複数の磁性メモリを、前記磁性層の切り欠き部における直線部が互いに略平行となるようにして配置してなる磁性メモリアレイ。

【請求項 2】 前記磁性メモリの、前記磁性層の前記切り欠き部における前記直線部は、記録用の外部磁場の印加方向と略平行となるように配置したことを特徴とする、請求項 1 に記載の磁性メモリアレイ。

【請求項 3】 前記外部磁場の印加により、前記磁性層内部には右回り（時計回り）又は左回り（反時計回り）の面内方向の磁化が誘起されることを特徴とする、請求項 1 又は 2 に記載の磁性メモリアレイ。

【請求項 4】 前記磁性層の、前記磁性層の外周部における切り欠き部の高さを h とし、前記磁性層の外径を $H1$ とした場合において、前記切り欠き部の高さ h と前記外径 $H1$ との比（ $h/H1$ ）が 0.01 以上であることを特徴とする、請求項 1 ～ 3 のいずれか一に記載の磁性メモリアレイ。

【請求項 5】 前記磁性メモリの、前記磁性層は室温強磁性体から構成されたことを特徴とする、請求項 1 ～ 4 のいずれか一に記載の磁性メモリアレイ。

【請求項 6】 前記磁性メモリの、前記磁性層の厚さが $1\text{ nm} \sim 10\text{ nm}$ であることを特徴とする、請求項 1 ～ 5 のいずれか一に記載の磁性メモリアレイ。

【請求項 7】 前記磁性メモリは、前記磁性層上において、非磁性層を介してリング形状の膜面を有する追加の磁性層を含むことを特徴とする、請求項 1 ～ 6 のいずれか一に記載の磁性メモリアレイ。

【請求項 8】 前記磁性メモリの、前記追加の磁性層は室温強磁性体から構成されたことを特徴とする、請求項 7 に記載の磁性メモリアレイ。

【請求項 9】 前記磁性メモリの、前記追加の磁性層の厚さが $1\text{ nm} \sim 10\text{ nm}$ であることを特徴とする、請求項 7 又は 8 に記載の磁性メモリアレイ。

【請求項 10】 前記磁性メモリは、前記追加の磁性層の、前記磁性層と対向す

る主面と隣接するようにして反強磁性層を含むことを特徴とする、請求項 7～9 のいずれか一に記載の磁性メモリアレイ。

【請求項 1 1】 前記磁性メモリの、前記追加の磁性層は、前記リング状の膜面に沿って右回り（時計回り）又は左回り（反時計回り）に磁化されていることを特徴とする、請求項 7～1 0 のいずれか一に記載の磁性メモリアレイ。

【請求項 1 2】 前記磁性メモリの、前記追加の磁性層における磁化の向きが固定されていることを特徴とする、請求項 1 0 又は 1 1 に記載の磁性メモリアレイ。

【請求項 1 3】 リング形状の膜面を有する磁性層を含む複数の磁性メモリを具える磁性メモリアレイへの書き込み方法であって、

前記磁性メモリの、前記磁性層の外周部を円弧状に切り欠く工程と、

前記磁性層の切り欠き部における直線部が互いに略平行となるようにして、前記複数の磁性メモリを配置し、前記磁性メモリアレイを形成する工程と、

前記磁性メモリアレイに対して外部磁場を印加することにより、前記磁性メモリアレイに対して記録動作を実行する工程と、
を具えることを特徴とする、磁性メモリアレイの書き込み方法。

【請求項 1 4】 前記外部磁場は、前記磁性メモリの、前記磁性層の前記切り欠き部における前記直線部と略平行となるように印加することを特徴とする、請求項 1 3 に記載の磁性メモリアレイの書き込み方法。

【請求項 1 5】 前記外部磁場の印加により、前記磁性層内部に右回り（時計回り）又は左回り（反時計回り）の面内方向の磁化を誘起することを特徴とする、請求項 1 3 は 1 4 に記載の磁性メモリアレイの書き込み方法。

【請求項 1 6】 前記磁性層の、前記磁性層の外周部における切り欠き部の高さを h とし、前記磁性層の外径を $H 1$ とした場合において、前記切り欠き部の高さ h と前記外径 $H 1$ との比（ $h / H 1$ ）を 0. 0 1 以上とすることを特徴とする、請求項 1 3～1 5 のいずれか一に記載の磁性メモリアレイの書き込み方法。

【請求項 1 7】 前記磁性メモリの、前記磁性層は室温強磁性体から構成することを特徴とする、請求項 1 3～1 6 のいずれか一に記載の磁性メモリアレイの書き込み方法。

【請求項 1 8】 前記磁性メモリの、前記磁性層の厚さを $1\text{ nm} \sim 10\text{ nm}$ にすることを特徴とする、請求項 1 3 ～ 1 7 のいずれかに記載の磁性メモリアレイの書き込み方法。

【請求項 1 9】 リング形状の膜面を有する磁性層を含む複数の磁性メモリを具える磁性メモリアレイからの読み出し方法であって、

前記磁性メモリの、前記磁性層の外周部を円弧状に切り欠く工程と、

前記磁性メモリの、前記磁性層上に、非磁性層を介してリング状の膜面を有する追加の磁性層を設ける工程と、

前記磁性層の切り欠き部における直線部が互いに略平行となるようにして、前記複数の磁性メモリを配置し、前記磁性メモリアレイを形成する工程と、

前記磁性メモリアレイに対して外部磁場を印加することにより、前記磁性メモリアレイに対して記録動作を実行し、前記磁性メモリにおける前記磁性層に対して右回り（時計回り）又は左回り（反時計回り）に磁化する工程と、

前記追加の磁性層を前記リング状の膜面に沿って右回り（時計回り）又は左回り（反時計回り）に磁化し、前記磁性層の、前記右回り（時計回り）又は前記左回り（反時計回り）に磁化に対応させて記録した情報を、前記追加の磁性層における磁化の向きと前記磁性層における磁化の向きとに依存した抵抗値に基づく電流値変化から読み出す工程と、

を具えることを特徴とする、磁性メモリアレイの読み出し方法。

【請求項 2 0】 前記追加の磁性層の、前記磁性層と対向する主面と隣接するようにして反強磁性層を設け、前記追加の磁性層の磁化の向きを固定する工程を具えることを特徴とする、請求項 1 9 に記載の磁性メモリアレイの読み出し方法。

【請求項 2 1】 前記磁性層の外周部における切り欠き部の高さを h とし、前記磁性層の外径を H_1 とした場合において、前記切り欠き部の高さ h と前記外径 H_1 との比 (h/H_1) を 0.01 以上とすることを特徴とする、請求項 1 9 又は 2 0 に記載の磁性メモリアレイの読み出し方法。

【請求項 2 2】 前記磁性層は室温強磁性体から構成することを特徴とする、請求項 1 9 ～ 2 1 のいずれかに記載の磁性メモリアレイの読み出し方法。

【請求項 2 3】 前記磁性層の厚さを $1\text{ nm} \sim 10\text{ nm}$ にすることを特徴とする

、請求項 1 9 ～ 2 2 のいずれか一に記載の磁性メモリアレイの読み出し方法。

【請求項 2 4】 前記追加の磁性層の厚さを 1 n m ～ 1 0 n m にすることを特徴とする、請求項 1 9 ～ 2 3 のいずれか一に記載の磁性メモリの読み出し方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、マグネティック・ランダム・アクセス・メモリ (M R A M) として好適に用いることのできる不揮発性の磁性メモリアレイ、さらには前記磁性メモリアレイに対する情報の書き込み方法及び読み出し方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

種々の電子機器が宇宙空間などの特殊な環境下で用いられるようになり、このため放射線などに晒されても記録された情報が失われることのない記録装置の確立が求められている。かかる観点より、放射線などに対する耐性が高く、情報の不揮発性を有するとともに、簡単な構造の磁性メモリセルを有する M R A M の開発が盛んに進められている。

【 0 0 0 3 】

従来の磁性メモリセルは長方形状を呈し、その磁化の向きに応じて 0 又は 1 の情報を記録するようにしている。しかしながら、このような磁性メモリセルにおいては、その形状に起因して前記磁化に起因した磁束がセル外部へ漏洩してしまっていた。一方で、M R A M の記録容量を増大させるべく、複数の磁性メモリセルを高密度で配列する試みがなされているが、この場合においては、上述した漏洩磁場によって隣接する磁性メモリセルに対して甚大な影響を与えてしまい、結果的に実用的な高密度 M R A M を得ることはできないでいた。

【 0 0 0 4 】

このような観点から、本発明者らは、磁性メモリの形状をリング形状とし、前記磁性メモリを前記リング形状に沿って右回り（時計回り）又は左回り（反時計回り）に渦状に磁化させ、これら磁化の向きに応じて 0 又は 1 の情報を記録するようにした磁性メモリを開発した（特願 2 0 0 2 - 7 3 6 8 1 参照）。

【 0 0 0 5 】

この場合においては、前記磁性メモリから磁束が漏洩しないため、これら磁性メモリを高密度に配列して例えばMRAMを作製した場合においても、漏洩磁場が隣接する磁性メモリに悪影響を与えないため、前記磁性メモリを高密度に集積することができるようになる。

【 0 0 0 6 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前記磁性メモリを構成する情報を記録するための磁性層の厚さが小さくなると、上述したような渦状の磁化を生ぜしめることが困難になり、前記渦状磁化を利用した情報の記録を実行することができない場合があった（「Physical Review Letters, 83巻、5号、p1042-1045（1999年）参照」）。

【 0 0 0 7 】

本発明は、磁性層の厚さに関係なく渦状磁化を生成することができ、前記渦状磁化の向きに応じて情報を安定的に記録できるようにした磁性メモリアレイを提供することを目的とする。さらには、前記磁性メモリに対する情報の書き込み方法及び読み出し方法を提供することを目的とする。

【 0 0 0 8 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成すべく、本発明は、外周部を円弧状に切り欠いてなる、リング形状の膜面を有する磁性層を含む複数の磁性メモリを、前記磁性層の切り欠き部における直線部が互いに略平行となるようにして配置してなる磁性メモリアレイに関する。

【 0 0 0 9 】

本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討を実施した。その結果、磁性メモリの、リング状の磁性層の外周の一部を、断面が垂直となるように切り欠くことによって、前記磁性層の厚さが小さい場合においても、前記磁性層中に右回り（時計回り）又は左回り（反時計回り）の渦状の磁化を簡易に生ぜしめることができることを見出した。そして、このような磁性メモリを複数配置して磁性メモ

リアレイを作製する際には、前記磁性層の前記切り欠き部における直線部が互いに略平行となるように設定することにより、前記磁性メモリアレイに対して、単一の外部磁場を印加するのみで、前記磁性メモリアレイに対する記録動作を実行でき、本発明の磁性メモリアレイを実用的な高密度記録媒体として提供できることを見出した。

【0010】

本発明によれば、前記磁性層を1nm～10nm程度まで薄くした場合においても、前記磁性層中に上述した渦状磁化を簡易に生ぜしめることができ、前記渦状磁化の向きに応じて0又は1の情報を記録することができる。

【0011】

また、前記磁性層からの前記渦状磁化に基づく漏洩磁場が発生しないため、前記磁性メモリアレイ中における、磁性メモリの配列密度を増大させた場合においても、隣接する磁性メモリ同士が前記漏洩磁場によって影響を受けることはない。

【0012】

本発明の磁性メモリのその他の特徴、並びに本発明の磁性メモリの記録方法及び読み出し方法については、以下の発明の実施の形態において詳細に説明する。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下、本発明を発明の実施の形態に則して詳細に説明する。

図1は、本発明の磁性メモリアレイを構成する磁性メモリ中の、磁性層の形状を概略的に示す図であり、図2は、図1に示す磁性層中の磁化状態を示す図である。

【0014】

図1に示すように、磁性層11はリング状を呈し、その外周部は垂直な断面を有するように円弧状に切り欠かれている。このように、磁性層11が切り欠き部12を有するリング状を呈することによって、例えば磁性層11の厚さを1nm～10nm程度まで小さくした場合においても、図2(a)及び(b)に示すように、磁性層11中に右回り(時計回り)又は左回り(反時計回り)の渦状磁化

を生ぜしめることができるようになる。

【0015】

したがって、図2に示すように、例えば右回りの渦状磁化に対して0を割り当て、左回りの渦状磁化に対して1を割り当てるようにすれば、これらの0又は1の値に応じて、磁性層11中に所定の情報を記録させることができるようになる。

【0016】

なお、磁性層11は、図2(a)から図2(b)の状態に移行する際、あるいは図2(b)から図2(a)の状態に移行する際、図2(c)に示すような磁化状態を経る。

【0017】

切り欠き部12の高さ h の、リング形状の磁性層11の外径 $H1$ に対する比($h/H1$)は、0.01以上であることが好ましく、さらには0.05以上であることが好ましい。磁性層11の外周部を上述したような大きさに切り欠くことにより、磁性層11を含む磁性メモリを複数配列して本発明の磁性メモリアレイを作製した場合において、比較的小さい外部磁場によって記録動作をより簡易かつ正確に行うことができるようになる。

【0018】

なお、前記比($h/H1$)の上限は特に規定されるものではないが、0.2であることが好ましい。前記比を0.2を超えて大きくしても本発明の作用効果のさらなる向上を図ることができず、磁性層11中に上述した渦状の磁化を生成させることができず、磁性層11を磁性メモリとして使用できなくなる場合がある。

【0019】

また、磁性層11のリング形状に保持するためには、切り欠き部12の高さ h と、磁性層11の外径 $H1$ 及び内径 $H2$ とは、 $h < (H1 - H2) / 2$ なる関係を満足する必要がある。

【0020】

磁性層11は、例えばNi-Fe、Ni-Fe-Co、及びCo-Feなどの

室温強磁性体から構成することができる。なお、室温強磁性体とは、室温において強磁性的性質を示す磁性体を意味し、上述した磁性材料の他に公知の磁性材料を含むことができる。

【 0 0 2 1 】

また、磁性層 1 1 の厚さは 1 n m ~ 1 0 n m に設定することが好ましく、さらには 3 n m ~ 5 n m に設定することが好ましい。これによって、十分な大きさの渦状磁化を生ぜしめることができ、0 又は 1 に対応した所定の情報を安定的に記録することができるようになる。

【 0 0 2 2 】

図 3 は、図 1 に示す磁性層を含む磁性メモリの具体的な一態様を示す平面図であり、図 4 は、図 3 に示す磁性メモリの側面図である。図 3 及び図 4 に示す磁性メモリ 3 0 においては、図 1 に示すような磁性層 2 1 上において、非磁性層 2 2 を介して追加の磁性層 2 3 が形成されるとともに、追加の磁性層 2 3 上において反強磁性層 2 4 が形成されている。磁性層 2 1 は、上述したように外周部を切り欠いたリング形状を呈しており、非磁性層 2 2 から反強磁性層 2 4 は磁性層 2 1 と同心円状に積層されてなり、それぞれリング形状を呈するように構成されている。

【 0 0 2 3 】

また、本態様においては、非磁性層 2 2 から反強磁性層 2 4 は、磁性層 2 1 と同一の膜面を有するように、磁性層 2 1 と同一の切り欠き部 3 2 を有するように構成されている。したがって、磁性メモリ 3 0 の切り欠き部 3 2 は切り欠き部 1 2 と同一の要件を満足する。

【 0 0 2 4 】

磁性層 2 1 は、上述したように右回り（時計回り）又は左回り（反時計回りに）に磁化され、その磁化に応じて 0 又は 1 が割り当てられ、所定の情報が記録されるようになっている。

【 0 0 2 5 】

図 3 に示す磁性メモリ 3 0 において、追加の磁性層 2 3 は、予め右回り（時計方向）又は左回り（反時計方向）に磁化されており、この磁化は反強磁性層 2 4

との交換結合によって固定されている。なお、磁性層 2 1 と追加の磁性層 2 3 とは非磁性層 2 2 によって磁氣的に分断されている。

【 0 0 2 6 】

磁性層 2 1 は、上述したような室温強磁性体から構成することができ、1 nm ～ 1 0 nm の厚さに形成することができる。また、追加の磁性層 2 3 についても同様の室温強磁性体から構成することができ、1 nm ～ 1 0 nm の厚さに形成する。

【 0 0 2 7 】

非磁性層 2 2 は、Cu、Ag、及びAuなどの非磁性材料から構成することができ、反強磁性層 2 4 はMn-Ir、Mn-Pt、及びFe-Mnなどの反強磁性材料から構成することができる。なお、非磁性層 2 2 の厚さ及び反強磁性層 2 4 の厚さは、それぞれ磁性層 2 1 及び追加の磁性層 2 3 間を磁氣的に分断できるように、さらには追加の磁性層 2 3 中の磁化を交換結合を通じて磁氣的に固定できるように適宜に設定する。

【 0 0 2 8 】

図 5 は、本発明の磁性メモリアレイの構成を概略的に示す平面図である。図 5 に示す磁性メモリアレイにおいては、図 3 及び図 4 に示す磁性メモリ 3 0 が、切り欠き部 3 2 が左上方を向くようにして縦 3 列、横 3 列で計 9 個配列されてなり、総ての磁性メモリ 3 0 の切り欠き部 3 2 における直線部 3 3 が互いに略平行になるように構成されている。磁性メモリ 3 0 の上部及び下部には、磁性メモリ 3 0、すなわち図 5 に示す磁性メモリアレイに対する書き込み動作と読み出し動作とを実行するための、上部配線 4 1 ～ 4 3 及び下部配線 5 1 ～ 5 3 が設けられている。

【 0 0 2 9 】

なお、図 5 に示す磁性メモリアレイにおいては、磁性メモリ 3 0 の配置数を 9 個に設定しているが、配置数は 9 個に限定されるものではなく、任意の数に設定することができる。また、図 5 に示す磁性メモリアレイにおいては、磁性メモリ 3 0 を縦 3 列及び横 3 列に配置しているが、実際の配置方法はこれに限定されるものではなく、必要に応じて任意の形態に配置することができる。

【 0 0 3 0 】

図 5 に示す磁性メモリアレイに対して書き込みを行う際には、書き込みを行うべき磁性メモリ 3 0 の上部及び下部に位置する配線に対して電流を流すことによって所定の磁場を生ぜしめ、この磁場を利用して書き込みを行う。例えば、右上方に位置する磁性メモリ 3 0 に対して書き込みを行う際には、上部配線 4 1 に対して上向きの電流 I_1 を流し、下部配線 5 1 に右向きの電流 I_2 を流す。すると、磁性メモリ 3 0 には、上向き電流 I_1 に起因した誘導磁場 B_1 と右向き電流 I_2 に起因した誘導磁場 B_2 との合成磁場 B が印加されることになり、磁性メモリ 3 0 の磁性層中には、図 2 (b) に示すような左回り（反時計回り）の磁化が生じるようになる。したがって、この磁化の向きに対して 0 又は 1 を割り当てることにより、磁性メモリ 3 0 に対する書き込みを実行することができるようになる。

【 0 0 3 1 】

このとき、合成磁場 B の向きは、磁性メモリ 3 0 の切り欠き部 3 2 における直線部 3 3 と略平行であることが好ましい。これによって、比較的小さい外部磁場によって記録動作をより簡易かつ正確に行うことができるようになる。この要件を満たすためには、上向き電流 I_1 及び右向き電流 I_2 の大きさを適宜に制御するとともに、磁性メモリ 3 0 の配置方向を適宜に制御する。

【 0 0 3 2 】

また、右上方に位置する磁性メモリ 3 0 の磁性層中に、図 2 (a) に示すような右回り（時計回り）の磁化を生ぜしめるような場合は、上部配線 4 1 及び下部配線 5 1 に対して、上向き電流 I_1 及び右向き電流 I_2 に代えて、下向き電流 I_3 及び左向き電流 I_4 を流すことによって、合成磁場 B と逆方向である右上方向の合成磁場 B_a を印加する。

【 0 0 3 3 】

なお、この場合においても、前記同様の理由から合成磁場 B_a の向きは、磁性メモリ 3 0 の切り欠き部 3 2 における直線部 3 3 と略平行であることが好ましい。

【 0 0 3 4 】

上記においては、右上方の位置する磁性メモリ 3 0 に対する書き込み動作について説明したが、他の磁性メモリ 3 0 に対する書き込み動作についても同様である。例えば、中央に位置する磁性メモリ 3 0 に対して書き込みを実行する際には、上部配線 4 2 及び下部配線 5 2 に対して、上向き電流 I_1 及び右向き電流 I_2 を流すことにより、合成磁場 B を生成することができ、図 2 (b) に示すような左回り（反時計回り）の磁化を生ぜしめることができる。同様に、上部配線 4 2 及び下部配線 5 2 に対して、下向き電流 I_3 及び左向き電流 I_4 を流すことにより、合成磁場 B_a を生成することができ、図 2 (a) に示すような右回り（時計回り）の磁化を生ぜしめることができる。

【 0 0 3 5 】

なお、上述した書き込み動作は、磁性メモリ 3 0 毎に行うこともできるが、複数の磁性メモリ 3 0 に対して同時に行うこともできる。

【 0 0 3 6 】

図 5 に示す磁性メモリアレイに書き込まれた情報を読み出すに際しては、磁性メモリ 3 0 を構成する追加の磁性層 2 3 の、反強磁性層 2 4 によって固定された磁化方向と、磁性層 2 1 の磁化方向との相対的な方向関係に基づく磁性メモリ 3 0 全体の電気抵抗値変化を利用して行う。例えば、磁性層 2 1 の磁化方向と追加の磁性層 2 3 の磁化方向とが同一の場合、磁性メモリ 3 0 の電気抵抗値は減少する。一方、磁性層 2 1 の磁化方向と追加の磁性層 2 3 の磁化方向とが反対である場合、磁性メモリ 3 0 の電気抵抗値は増大する。

【 0 0 3 7 】

したがって、磁性メモリ 3 0 を流れる電流は、磁性層 2 1 の磁化方向に起因した抵抗値変化に基づいて変化するので、追加の磁性層 2 3 の磁化方法が予め分かっているならば、前記電流変化によって磁性層 2 1 の磁化方向を知ることができ、この磁化方向に対して記録させた 0 又は 1 の情報を読み出すことができる。

【 0 0 3 8 】

図 5 に示す磁性メモリアレイにおいては、上部配線及び／又は下部配線に対して所定の電圧を印加し、そこを流れる電流値を計測することによって、磁性メモリセル 3 0 に書き込まれた情報を読み出すことができる。例えば、右上方に位置

する磁性メモリ 3 0 内に書き込まれた情報を読み出す際には、上部配線 4 1 及び／又は下部配線 5 1 内に所定の電圧を印加し、その結果これらの配線中を流れる電流値を読み取れば良い。

【 0 0 3 9 】

以上、具体例を示しながら発明の実施の形態に則して本発明を説明してきたが、本発明は上記内容に限定されるものではなく、本発明の範疇を逸脱しない範囲において、あらゆる変形や変更が可能である。

【 0 0 4 0 】

【発明の効果】

以上説明したように、磁性層の厚さに関係なく渦状磁化を生成することができ、前記渦状磁化の向きに応じて情報を安定的に記録できるようにした磁性メモリアレイを提供することができる。さらには、前記磁性メモリアレイに対する情報の書き込み方法及び読み出し方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の磁性メモリを構成する磁性層の形状を概略的に示す平面図である。

【図 2】 図 1 に示す磁性層中の磁化状態を示す図である。

【図 3】 磁性メモリの具体的な一態様を示す平面図である。

【図 4】 図 3 に示す磁性メモリの側面図である。

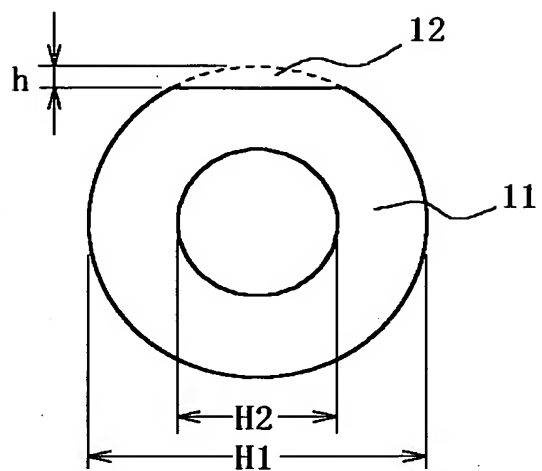
【図 5】 本発明の磁性メモリアレイの一例を示す平面図である。

【符号の説明】

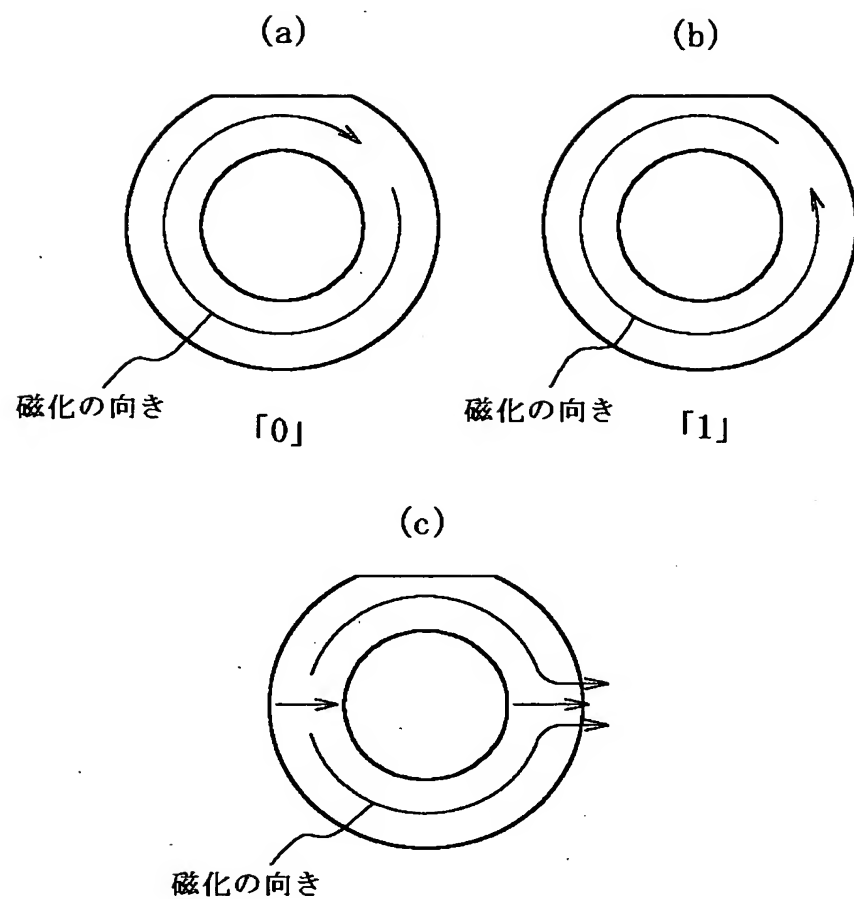
- 1 1、2 1 磁性層
- 1 2、3 2 切り欠き部
- 2 2 非磁性層
- 2 3 追加の磁性層
- 2 4 反強磁性層
- 3 0 磁性メモリ
- 4 1～4 3 上部配線
- 5 1～5 3 下部配線

【書類名】 図面

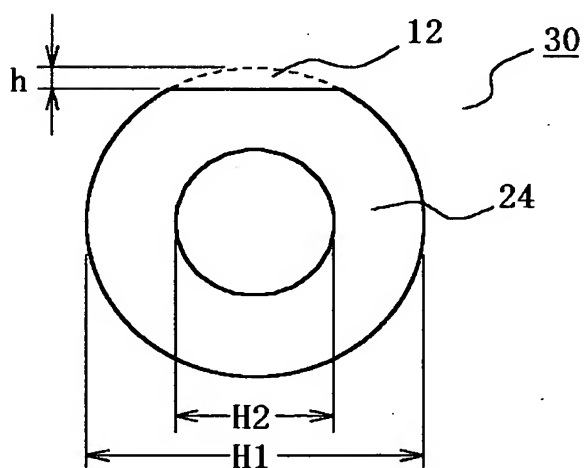
【図 1】



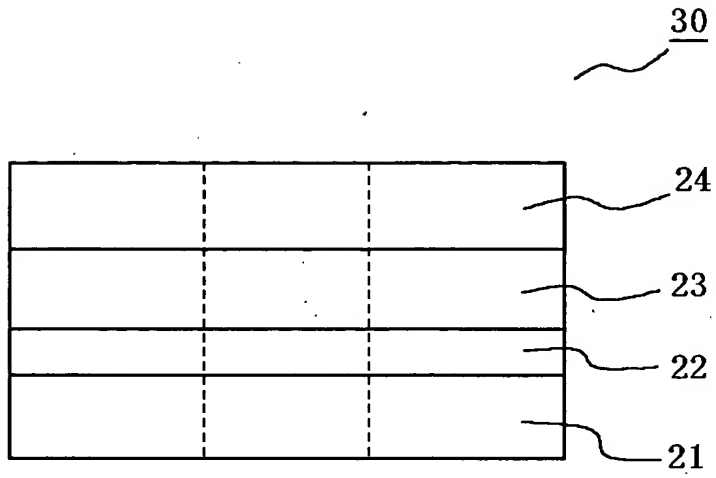
【図 2】



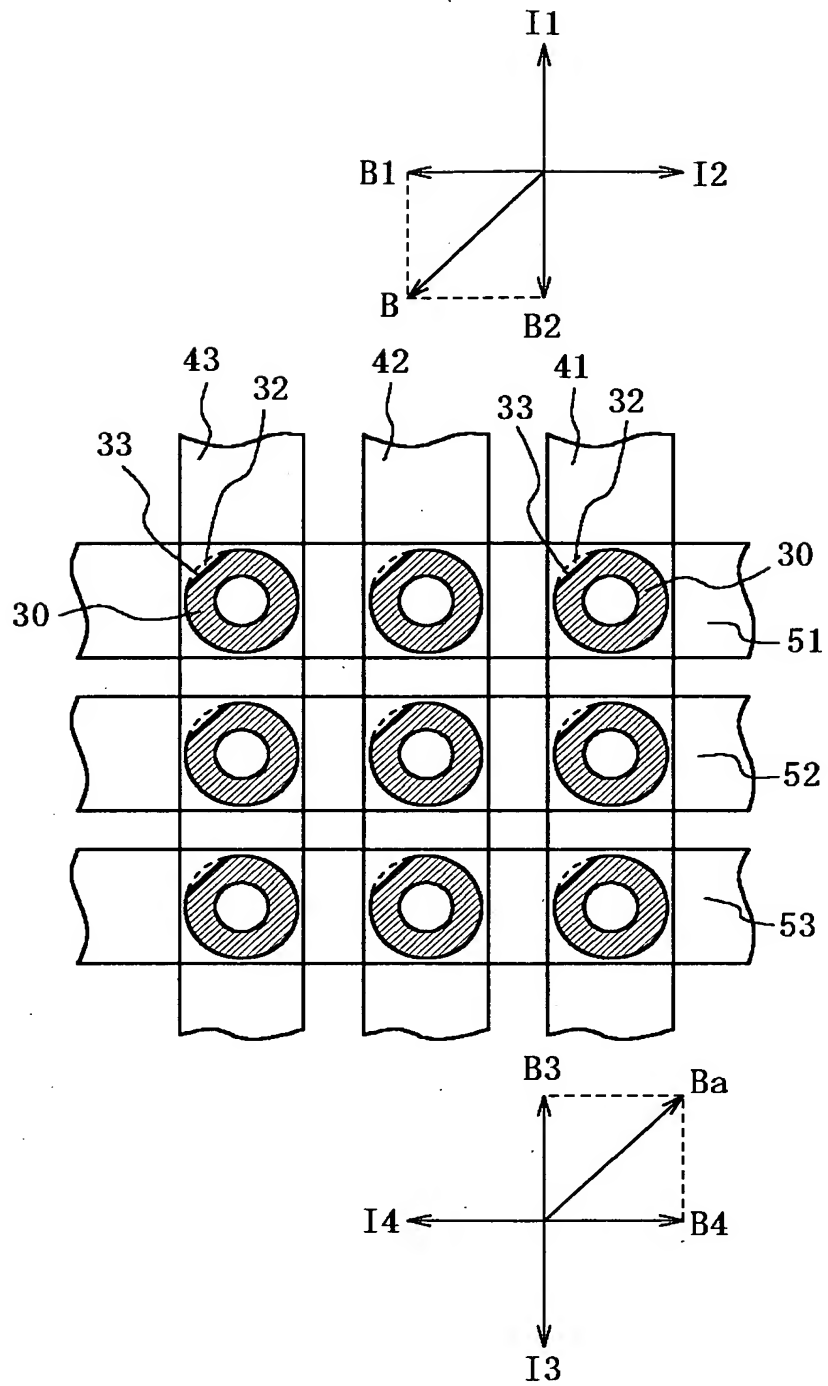
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 磁性層の厚さに関係なく渦状磁化を生成することができ、前記渦状磁化の向きに応じて情報を安定的に記録できるようにした磁性メモリアレイを提供する。

【解決手段】 外周部を円弧状に切り欠いてなる、リング形状の膜面を有する磁性層を含む複数の磁性メモリ 3 0 を、切り欠き部 3 2 における直線部 3 3 が互いに略平行となるようにして配置して、磁性メモリアレイを作製する。

【選択図】 図 5

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2002-362200
受付番号	50201893067
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0090
作成日	平成 14 年 12 月 16 日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	391016945
【住所又は居所】	大阪府吹田市山田丘 1 番 1 号
【氏名又は名称】	大阪大学長

【代理人】

申請人

【識別番号】	100072051
【住所又は居所】	東京都千代田区霞が関 3-2-4 霞山ビル 7 階
【氏名又は名称】	杉村 興作

【選任した代理人】

【識別番号】	100059258
【住所又は居所】	東京都千代田区霞が関 3-2-4 霞山ビル 7 階
【氏名又は名称】	杉村 暁秀

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [391016945]

1. 変更年月日 1991年 1月31日
[変更理由] 新規登録
住 所 大阪府吹田市山田丘1番1号
氏 名 大阪大学長